06

Интеркалированный самарий как агент, обеспечивающий возможность интеркалирования кислорода под монослойную графеновую пленку на иридии

© Е.Ю. Афанасьева¹, Е.В. Рутьков¹, Н.Р. Галль^{1,2}

¹ Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург ² Институт аналитического приборостроения РАН, Санкт-Петербург E-mail: afanaseva@ms.ioffe.rssi.ru

Поступило в Редакцию 2 февраля 2016 г.

С помощью времяпролетной термодесорбционной масс-спектрометрии и термоэлектронных методов показано, что кислород не интеркалирует под корректно выращенный графеновый монослой на иридии, по крайней мере при температуре T = 300-400 K и экспозициях ниже $12\,000$ L. Однако в случае предварительного интеркалирования атомами Sm пленки графена на иридии (степень покрытия $\theta_{\rm Sm} = 0.2-0.45$) наблюдается проникновение атомов кислорода под пленку графена. В интеркалированном состоянии атомы кислорода химически связаны с атомами самария и удерживаются под графеном до высоких температур (~ 2150 K).

Вопрос о возможности и механизмах интеркалирования кислорода под графен широко обсуждается в научной литературе. Такой процесс представляет огромный практический интерес, так как открывает один из наиболее прямых путей для выращивания под графеном диэлектрического окисного слоя с целью его изоляции от металла. В отношении объемного графита интеркалирование кислорода не наблюдалось [1], и имелась устойчивая точка зрения, что оно невозможно и в отношении монослойного графена. Так, многомесячная выдержка графена при комнатной температуре в атмосферных условиях не приводила к накоплению кислорода ни на его поверхности, ни в интеркалированном состоянии, а щелочные металлы (Cs, K), интеркалированные под графен, оставались неокисленными при таких экспозициях [2,3].

64

Однако описанная точка зрения была поколеблена рядом недавних работ [4-6], в которых авторы утверждают, что интеркалирование кислорода наблюдали для пленок графена со степенью покрытия $\theta = 0.5 - 1.0$ в интервале температур 350-600 К. Однако вопрос окончательно прояснен не был, и литературные данные носят существенно противоречивый характер. Так, авторы [5] утверждают, что при давлении кислорода $P \sim 10^{-3} - 10^{-5}$ Torr и вплоть до температуры подложки $T = 700 \,\mathrm{K}$ сплошная пленка графена на Ir (111) непроницаема для кислорода. Наоборот, в работе [6] приводятся данные в пользу того, что при давлении $P \sim 3.75 \cdot 10^{-3}$ Torr и $T \sim 470 - 520$ К кислород можно интеркалировать под графен до покрытий кислородом $\theta \approx 0.6$. Механизм интеркалирования, по утверждению авторов [6], заключается в проникновении молекул О2 через точечные дефекты и границы доменов с последующей диссоциацией на иридии. В то же время монослойный графен, описанный в [6], был выращен при температуре ниже 1500 К на поверхности монокристалла, причем никаких данных об однородности нагрева, о качестве графеновой пленки и о скорости закалки образца авторы не представляют. Учитывая огромные технические сложности с обеспечением однородного высокотемпературного нагрева монокристаллов и высоких скоростей поверхностной миграции углерода, есть все основания считать, что использованный там графен был далек от идеальности и видимо представлял собой ансамбль наноостровков с большим числом дефектов. Возможно, именно значительное число дефектов и стало причиной наблюдаемого авторами "интеркалирования кислорода".

Задачей данной работы является выяснение возможности проникнования кислорода под сплошную графеновую пленку, выращенную на Ir (111), а также влияния на этот процесс предварительно интеркалированных атомов самария.

Для изучения этого вопроса нами было проведено специальное исследование с помощью термодесорбционной времяпролетной массспектрометрии, способной измерять следовые концентрации кислорода, и группы термоэмиссионных методов, обеспечивающих возможность in situ характеризации графенового слоя. Экспериментальная установка и методика измерений описаны ранее [7]. В качестве подложек использовались текстурированные иридиевые ленты с выходом на поверхность грани (111), имеющие размеры $0.02 \times 1 \times 40 \text{ mm}^3$ и работу выхода $e\varphi = 5.75 \text{ eV}$, выход грани составлял 99.5%. Очистка лент от примесей проводилась путем последовательного отжига в кислороде

 $(P \sim 10^{-6} \text{ Torr})$ и в сверхвысоком вакууме при T = 1500-2000 K. Температура ленты измерялась оптическим микропирометром, однородность температуры в центральной области шириной $\sim 20 \text{ mm}$ составляла +/-5 K. В области низких температуро осуществлялась линейная экстраполяция зависимости температуры от тока накала ленты к комнатной температуре. В процессе нагрева ленты с постоянной скоростью можно было регистрировать как термодесорбционные спектры, так и термоэлектронный ток.

Потоки термодесорбирующихся атомов Sm и молекул (O₂, CO, CO₂) регистрировались импульсным времяпролетным масс-спектрометром по токам соответствующих ионов. Термоэлектронный ток собирался коллектором в виде такой же иридиевой ленты, расположенной в непосредственной близости (5 mm) от рабочей ленты. На коллектор подавалось напряжение +500 V. Давление остаточных газов в установке не превышало 10⁻¹⁰ Torr.

Для образование графеновой пленки на нагретую до $T = 1750 \,\mathrm{K}$ иридиевую ленту направлялся поток молекул C₆₀. Молекулы фуллеренов распадались на поверхности Ir с образованием графена [2]. Процесс распада молекул заканчивался в момент образования сплошной графеновой пленки, что регистрировалось по выходу тока термоэлектронной эмиссии в насыщение. За счет активной поверхностной миграции и на обратной (незапыляемой) стороне ленты образовывался слой графена. По данным оже-спектроскопии никаких примесей на поверхности не наблюдалось, форма C_{KVV} оже-линии была графеновая [3]. Имелась возможность многократно создавать и разрушать графеновый слой без развакуумирования установки.

Выдержка так приготовленного графена в атмосфере кислорода в интервале давлений $10^{-6}-10^{-5}$ Torr в течение 20 min (экспозиционная доза 12000 L) не приводила к какому-либо накоплению кислорода на поверхности: при нагреве вплоть до T = 2150 K не наблюдалась десорбция ни O₂, ни CO или CO₂. Таким образом, можно утверждать, что кислород не проникает под хорошо выращенный графен, по крайней мере в описанных выше условиях.

Мы предположили, что использование интеркалированных атомов, обладающих одновременно и высоким сродством к кислороду, и значительной энергией связи с иридиевой подложкой, может создать искусственные дефекты, облегчающие интеркалирование кислорода под графен. В качестве такого интеркалянта использовался Sm.



Рис. 1. Зависимости тока термоэлектронной эмиссии с иридиевой ленты от температуры в процессе ее нагрева: I — после напыления Sm на Ir до $\theta_{\rm Sm} = 0.75$, 2 — после напыления Sm на монослойную пленку графена на Ir до $\theta_{\rm Sm} = 0.75$, 3 — с пленки графена на иридии. Температура адсорбции самария T = 300 K. Скорость нагрева $200 \text{ K} \cdot \text{s}^{-1}$.

Напыление самария на чистый иридий приводит к его адсорбции на поверхности и значительному понижению работы выхода. На рис. 1 представлена зависимость тока термоэлектронной эмиссии с иридиевой ленты от температуры $I^-(T)$ при ее нагреве с постоянной скоростью, после адсорбции на ней атомов Sm до покрытия $\theta = 0.75$ (кривая I). За монослойную концентрацию атомов Sm ($N_m = 8.75 \cdot 10^{14}$ at · cm⁻²) принята концентрация атомов самария в двумерной гексагональной струк-



Рис. 2. Термодесорбционные спектры атомов Sm с иридиевой ленты для начальной степени покрытия $\theta_{\rm Sm} = 0.75$: *1* — после напыление Sm на Ir, *2* — после напыление Sm на монослойную пленку графена на Ir. Температура адсорбции самария *T* = 300 K. Скорость нагрева 200 K · s⁻¹.

туре с параметрами, равными грани (0001) объемной решетки α -Sm [8]. Видно, что термоэлектронный ток фиксируется при T > 1100 К. Однако если самарий в той же дозе нанести на поверхность монослоя графена на иридии, то зависимость $I^{-}(T)$ сместится на ~ 500 К в область более высоких температур (кривая 2, рис. 1), причем ее начальный участок практически совпадает с аналогичной зависимостью для чистого (без самария) графена (кривая 3, рис. 1).

На рис. 2 представлены термодесорбционные спектры самария, записанные одновременно с регистрацией зависимостей $I^-(T)$ (рис. 1). Термодесорбционный пик Sm, предварительно напыленного на иридий без графена (кривая I, рис. 2), отражает десорбцию атомов самария из

соединения с Ir, которое образуется в процессе нагрева до $T \le 1100 \text{ K}$ при регистрации термодесорбционных спектров [7]. Работа выхода такой поверхности составляет $\sim 2.8 \text{ eV}$ [9] и ток термоэлектронной эмиссии с нее регистрируется при $T \ge 1100 \text{ K}$ (кривая *1*, рис. 1).

Как видно из спектра термодесорбции самария с графена на иридии (кривая 2, рис. 2), при T = 1150 К на поверхности остается значительное количество самария — десорбировалось ~ 10% от первоначального покрытия ($\theta = 0.75$). Термоэлектронная эмиссия с такой поверхности (кривая 2, рис. 1) начинается в той же температурной области, что и с пленки графена на иридии без самария (кривая 3, рис. 1). Таким образом, можно утверждать, что самарий, нанесенный на поверхность графена, проникает под него и после нагрева до T = 1100-1200 К остается только в интеркалированом состоянии, практически не меняя работу выхода графена.

Кислород адсорбируется при комнатной температуре на поверхности чистого иридия вплоть до покрытий порядка $\theta = 0.5$ [10]; его количество не зависит от экспозиции при дозе, превышающей 1000 L. Выдержка графеновой пленки в кислороде при T = 300-400 К вплоть до доз $12\,000\,\text{L}~(20\,\text{min},\,P\sim10^{-5}\,\text{Torr})$ не приводит к появлению его в адсорбционном слое: десорбция молекул О2 в процессе последующего нагрева не происходит, также не наблюдается десорбция молекул СО или СО2. Видимо, высококачественная графеновая пленка пассивна по отношению к адсорбции молекулярного кислорода, либо давление кислорода в нашей работе ($\sim 10^{-5}$ Torr) недостаточно для его интеркалирования. Ситуация меняется, если перед экспозицией в кислороде интеркалировать под графен атомы Sm. Самарий интеркалировался двумя способами: 1) напылением Sm при комнатной температуре до $\theta_{\rm Sm} = 0.45$ с последующим отжигом при T = 1100 K, 2) напылением Sm при $T = 1100 \,\mathrm{K}$ до $\theta_{\mathrm{Sm}} = 0.2$. Затем пленку выдерживали в кислороде при $T = 300 \,\mathrm{K}$ (доза $12\,000 \,\mathrm{L}$).

О наличии кислорода на поверхности судили по термодесорбции молекул СО, так как не наблюдалось заметной десорбции O₂ и CO₂. На рис. 3 приведены термодесорбционные спектры СО после экспозиции в кислороде системы самарий—графен—иридий, с $\theta_{\rm Sm} = 0.45$ (кривая 2) и с $\theta_{\rm Sm} = 0.2$ (кривая 3). Видно, что в отличие от системы графен—иридий кислород присутствует в адсорбционном слое. О количестве атомов кислорода на поверхности можно судить, сравнивая площади под термодесорбционной кривой O₂ с чистого Ir, на котором он адсорбируется



Рис. 3. Термодесорбционные спектры молекул O₂ (*1*) и CO (*2*, *3*) после экспозиции в атмосфере кислорода (12 000 L, T = 300 K): *1* — чистой Іг ленты; *2*, *3* — Іг ленты с монослоем графена, интеркалированным атомами самария (*2* — до $\theta_{\rm Sm} = 0.45$ напылением Sm при T = 300 K с последующим нагревом до 1100 K; *3* — до $\theta_{\rm Sm} = 0.2$ напылением Sm при T = 1100 K). Скорость нагрева 200 K · s⁻¹.

диссоциативно (в насыщении $N_m = 7.8 \cdot 10^{14} \, \mathrm{at} \cdot \mathrm{cm}^{-2})$ [10] (рис. 3, кривая *I*) и соответствующей кривой термодесорбции СО (рис. 3, кривые 2 и 3). По нашим оценкам, количество кислорода в случае кривой 2 составляет $N \sim 6.5 \cdot 10^{14} \, \mathrm{at} \cdot \mathrm{cm}^{-2}$, а случае кривой 3 — $N \sim 2 \cdot 10^{14} \, \mathrm{at} \cdot \mathrm{cm}^{-2}$.

Форма термодесорбционных пиков очень сложная: она отражает многообразие физико-химических процессов, протекающих под графе-

новой пленкой с участием кислорода, самария, углерода и иридия. Термодесорбционный пик при T = 1000-1200 К на кривых 2 и 3 (рис. 3) нами связывается с травлением дефектов графеновой пленки интеркалированными атомами кислорода аналогично тому, как это наблюдалось в работе [11]. Температуры десорбции СО в остальных фазах достаточно высоки — десорбция СО наблюдается вплоть до температур термического разрушения графена [12]. Детальная расшифровка их природы требует отдельного исследования и выходит за пределы данной работы.

Следует отметить, что задача получения графеновой пленки на полуторном оксиде самария, обладающем высокой диэлектрической проницаемостью ~ 18 и запрещенной зоной $\sim 5 \, {\rm eV}$ [13], представляет особый интерес для практических приложений в наноэлектронике на основе графена. Представленные в настоящей работе данные открывают путь для выращивания такого окисла под графеном.

Таким образом, интеркалированный самарий выступает как физикохимический агент, обеспечивающий возможность проникновения кислорода под графеновый слой. Под графеном кислород находится, скорее всего, в виде соединения с самарием, которое при высокотемпературной десорбции разрушается, обеспечивая наблюдаемый в эксперименте слет молекул СО и сложную форму термодесорбционного спектра.

Список литературы

- [1] Dresselhause M.S., Dresselhause G. // Adv. Phys. 1981. V. 30. P. 139.
- [2] Rut'kov E.V., Gall N.R. // Physics and Application of Graphene Experiments. Ed. S. Mikhailov. Intech Open Access Publisher, Rijeca-L. 2011. P. 293–326.
- [3] Gall N.R., Rut'kov E.V., Tontegode A.Ya. // Inter. J. Mod. Phys. B. 1997. V. 11. P. 1865–1911.
- [4] Hui Zhang, Qiang Fu, Yi Cui, Dali Tan, Xinhe Bao // J. Phys. Chem. C. 2009.
 V. 113. P. 8296–8301.
- [5] Grånäs E., Knudsen J., Schröder U.A., Gerber T., Busse C., Arman M.A., Schulte K., Andersen J.N., Michely T. // ASC Nano. 2012. V. 6. P. 9951–9963.
- [6] Larciprete R., Ulstrup S., Lacovig P., Dalmiglio M., Bianchi M., Mazzola F., Hornekar L., Orlando F., Baraldi A., Hofmann P., Lizzit S. // ASC Nano. 2012. V. 6. P. 9551–9558.
- [7] Афанасьева Е.Ю. // ФТТ. 2014. Т. 56. В. 8. С. 1588-1592.
- [8] Логинов М.В., Митцев М.А., Плешков В.А. // ФТТ. 1992. Т. 34. В. 10. С. 3125.

- [9] Абдуллаев Р.М., Тонтегоде А.Я., Юсифов Ф.К. // ФТТ. 1978. Т. 20. В. 8. С. 2343–2356.
- [10] Ivanov V.P., Boreskov G.K., Savchenko V.I., Egelhoff W.F., Weinberg W.H. // Surf. Sci. 1976. V. 61. P. 207–220.
- [11] Агеев В.Н., Соловьев С.М., Тонтегоде А.Я. // ФТТ. 1981. Т. 23. В. 8. С. 2280– 2289.
- [12] Галль Н.Р., Рутьков Е.В. Физика поверхности твердых тел. Графен и графит на поверхности твердых тел: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. 160 с.
- [13] Wen Chiao Chin, Kuan Yew Cheong, Zainuriah Hassan // Mater. Sci. Semicond. Proces. 2010. V. 13. P. 303–314.